

中科院上海光机所光电事业部产品介绍

主要性能参数						
单晶	掺杂	导电类型	载流子浓度 cm-3	位错密度 cm-2	生长方法 最大尺寸	标准基片
GaAs	None	Si	/	<5×10 <sup>5</sup>	LEC	Dia3 " × 0.5
	Si	N	>5×10 <sup>17</sup>		HB	Dia3" 0.5
	Cr	Si	/			
	Fe	N	~2×10 <sup>18</sup>			
	Zn	P	>5×10 <sup>17</sup>			
尺寸 (mm)		25×25×0.5mm、10×10×0.5mm、10×5×0.5mm、5×5×0.5mm 可按照客户需求，定制特殊方向和尺寸的衬底				
表面粗糙度		Surface roughness(Ra): <=5A 可提供原子粒显微镜 (AFM) 检测报告				
抛光		单面或双面				
包装		100 级洁净袋，1000 级超净室				

电话 :021-69918486, 69918652, E-mail:gzhchen@siom.ac.cn;sales@sgcrystal.com

网址 :www.sgcrystal.com